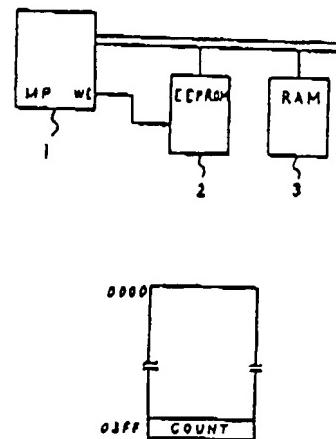


[34] STORAGE DEVICE

(11) 59-162695 (A) (43) 13.9.1984 (19) JP
(21) Appl. No. 58-36964 (22) 7.3.1983
(71) NIPPON DENKI K.K. (72) TOSHIO NINOMIYA(1)
(51) Int. Cl'. G11C17/00

PURPOSE: To secure the reliability of storage contents easily by controlling the frequency of writing to a nonvolatile memory.

CONSTITUTION: A microprocessor is connected to a nonvolatile and electrically erasable programmable ROM (EEPROM)2 and an RAM3. The processor 1 writes the frequency of writing up to now in a specific address (03FF) of the memory 2 prior to writing to the memory 2. The processor 1 reads the frequency COUNT of writing by a write enable signal WE to the memory 2 before writing data in the memory 2; when the frequency does not exceed a secured frequency N of writing, the value COUNT is increased by one to perform the writing to the memory 2, and when so, data to be written in the memory 2 is saved on an external storage device such as a floppy disk to let an operator know that the memory 2 should be replaced.



⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A)

昭59-162695

⑫ Int. Cl.³
G 11 C 17/00

識別記号
101

厅内整理番号
6549-5B

⑬ 公開 昭和59年(1984)9月13日

発明の数 I
審査請求 未請求

(全 2 頁)

④ 記憶装置

⑤ 特 願 昭58-36964

⑥ 出 願 昭58(1983)3月7日

⑦ 発明者 二宮敏雄

東京都港区芝五丁目33番1号日
本電気株式会社内

⑧ 発明者 池田貞信

東京都港区芝五丁目33番1号日
本電気株式会社内

⑨ 出願人 日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目33番1号

⑩ 代理人 弁理士 内原晋

明細書

1. 発明の名称

記憶装置

2. 特許請求の範囲

不揮発性のメモリの特定箇所に書き込み回数を記憶しておくエリアを設けたことを特徴とする記憶装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、不揮発性の半導体メモリをもつ記憶装置に関する。

電気的に読み出しおよび書き込みが可能で電源を切斷しても、その内容が保持されるこの種の不揮発性半導体メモリへの書き込み可能回数は 10^3 ~ 10^6 回程度である。ところが従来の紫外線消去方式とは異なり電気的に消去が可能であるのでメモリ内容の書き換えは装置に実装され電源を入れたまま行うことができるようになり、その結果として書き換

えが頻繁に行われるメモリとして使用されるようになってきた。

このようなアプリケーションにおいては、書き込まれた情報が正しく記憶されているか常に確認し、その内容を保証する必要がある。

従って本発明の目的は、不揮発性メモリの書き込み回数の管理を行なうことによって、記憶内容の信頼性の保証を簡便に実施することのできる記憶装置を提供することにある。

本発明によれば、電気的に消去及び書き込みが可能な不揮発性メモリの特定箇所にその時点までの書き込み回数を記憶させ書き込みを行うたびに、書き込み回数を確認することを特徴とする記憶装置が得られる。

次に本発明の実施例について図面を参照して本発明を詳細に説明する。

第1図は、本発明の一実施例の構成をブロック図で示したものであり、マイクロプロセッサバスを介して不揮発性電気的に消去可能なプログラマブル・リード・オンリー・メモリ (EEPROM)

特開昭59-162695(2)

のエリアを確保しておくことによって LRC にによる不揮発性メモリ 2 のチェックもできる。

以上のように、メモリ自身の不揮発性を利用し、保証された書き込み回数内で使用することを管理する機能を設けることによって不揮発性メモリの使用上の信頼性を簡便に保証することができる。

本発明は以上説明したように、電気的に消去及び書き込みが可能な不揮発性メモリの特定番地に書き込み回数を記憶しておくことにより、保証された書き込み回数内で使用することを管理することができ、使用上の信頼性を簡便に保証する効果がある。

4. 図面の簡単な説明

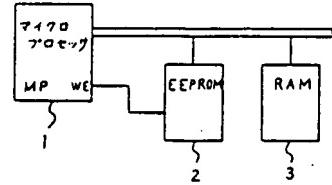
第 1 図は、本発明の一実施例のブロック図、第 2 図は不揮発性メモリのメモリエリアを示す図、第 3 図は、不揮発性メモリの書き込み時の制御を示す流れ図、第 4 図は不揮発性メモリの特定番地を LRC に利用した例である。

代理人 弁理士 内原晋

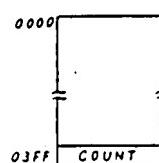


第 3 図

第 1 図



第 2 図



(書き込み信号)

不揮発性メモリより
書き込み回数(COUNT)を読み込む

書き込み回数が
保証された書き込み回数内か? COUNT ≤ N
No

Yes
書き込み回数の更新
COUNT ← COUNT + 1

[書き込み実行]

書き込み不可であることを
オペレーターに知らせる

第 4 図

